PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-319510

(43)Date of publication of application: 21.11.2000

(51)Int.Cl.

CO8L 79/08 G02F 1/1337

(21)Application number : 11-133653

(22)Date of filing:

14.05.1999

(71)Applicant : JSR CORP

(72)Inventor: NATSUI TORU

NAKADA SHOICHI MAKITA MINORU KIMURA MASAYUKI **BESSHO NOBUO** KIMURA SHINICHI TAKEUCHI YASUMASA

(54) LIQUID CRYSTAL ALIGNMENT AGENT AND LIQUID CRYSTAL ALIGNMENT TREATMENT (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a liquid crystal alignment agent capable of giving a liquid crystal alignment layer having an angle of pre-tilt produced by irradiation of radioactive rays without any rubbing treatment, by compounding plural kinds of compounds selected from a group comprising a specific polyimide, a polymer having a specified structure and a compound having a specified structure.

SOLUTION: This liquid crystal alignment agent contains at least two kinds of compounds selected from the group consisting of (A) a polyimide having a structure of the formula: P1-CH=CH-CO-Q1 (P1 and Q1 are each a divalent organic radical having one or more aromatic rings) in the main chain, (B) a polymer having at least one structure selected from a group of structures of the formulae: P2-CH=CH-CO-Q2 (P2 is a divalent organic radical having one or more aromatic rings; Q2 is a

monovalent organic radical having one or more aromatic

 $-P^{3}-CH=CH-CO-Q^{3}$

rings) and P3-CH=CH-CO-Q3 (P3 is a trivalent organic radical having one or more aromatic rings; Q3 is a monovalent organic radical having one or more aromatic rings), and (C) a compound having a structure of the formula: P4-CH-CO-Q4 (P4 and Q4 are each a monovalent organic radical having one or more aromatic rings).

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顯公開番号 特開2000-319510 (P2000-319510A)

(43)公開日 平成12年11月21日(2000.11.21)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C08L 79/08		C 0 8 L 79/08	Z 2H090
G 0 2 F 1/1337	505	G 0 2 F 1/1337	505 4J002
	5 2 5		5 2 5

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 12 頁)

(21)出顯番号	特顯平11-133653	(71)出題人 000004178
		ジェイエスアール株式会社
(22)出顯日	平成11年5月14日(1999.5.14)	東京都中央区築地2丁目11番24号
		(72) 発明者 夏井 亨
		東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ
		エスアール株式会社内
		(72)発明者 中田 正一
		東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ
		エスアール株式会社内
		(74)代理人 100080609
		弁理士 大島 正孝

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶配向剤および液晶配向処理方法

(57)【要約】

【課題】 ラビング処理を行わず、無偏光あるいは直線 偏光された放射線の照射によりプレチルト角を有する液 晶配向膜を付与することが可能な液晶配向剤を提供す る。

【解決手段】 放射線感応性基を有するポリイミドと放射線感応性基を有する、ポリイミド以外の重合体または 化合物を含有する液晶配向剤。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 下記式(I) $-P_{1}-CH=CH-CO-O_{1}-$ ここで、P¹およびQ¹は同一もしくは異なり、芳香環を 有する2価の有機基である、で表される構造を主鎖に有*

1

P'-CH=CH-CO-Q'

ここで、P³は芳香環を含有する3価の有機基でありそ してQ³は芳香環を含有する1価の有機基である、で表 わされる構造よりなる群から選ばれる少なくとも1つの 構造を有する重合体並びに(C)下記一般式(IV)P¹ $-CH = CH - CO - O^{\dagger}$ · · · · · (IV) ここで、P[†]およびO[†]は同一もしくは異なり、芳香環を 有する1価の有機基である、で表わされる構造を有する 化合物よりなる群から選ばれる少なくとも2種を含有す ることを特徴とする液晶配向剤。

【請求項2】 請求項1記載の液晶配向剤から得られた 液晶配向膜に放射線を照射することを特徴とする液晶配 向処理方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶配向剤および 液晶配向処理方法に関する。さらに詳しくは、ラビング 処理を行わずに、放射線の照射によって、プレチルト角 を有する液晶配向能を付与することが可能な液晶配向剤 および液晶配向処理方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、正の誘電異方性を有するネマチッ ク型液晶を、液晶配向膜を有する透明電極付き基板でサ ンドイッチ構造にし、液晶分子の長軸が基板間で90度 30 以上連続的に捻れるようにしてなるTN(Twisted Nem atic) 型、STN (Super Twisted Nematic) 型液晶 セルを有する液晶表示素子が知られている。

【0003】前記液晶セルにおける液晶を配向させる手 段には、基板表面に有機膜を形成し、次いでその有機膜 表面をレーヨンなどの布材で一方向にこすることにより 液晶配向能を付与する(ラビング処理を施す)方法、基 板表面に酸化珪素を斜方蒸着する方法、ラングミュア・ ブロジェット法(LB法)を用いて長鎖アルキル基を有 する単分子膜を形成する方法などがあるが、処理する基 板のサイズに制約があったり、液晶の配向均一性が不十 分なため、工業的には処理時間や処理コストの面で有利 なラビング処理による液晶の配向が一般的である。

【0004】しかしながら、液晶の配向をラビング処理 によって行うと、その工程中にほこりが発生したり、静 電気が発生しやすいという問題点がある。静電気が発生 すると、配向膜表面にほこりが付着し、表示不良が発生 する原因となり、またTFT (thin film transisto r) 素子を有する基板の場合、発生した静電気によって TFT素子の回路破壊が起こり、歩留まり低下の原因と 50

* するポリイミド、(B) 下記式(II)

 $-P^{2}-CH=CH-CO-O^{2}$ ここで、P²は芳香環を含有する2価の有機基でありそ してQ⁶は芳香環を含有する1価の有機基である、で表 わされる構造および下記式(III)

もなる。さらに、今後ますます高精彩化される液晶表示 素子においては、画素の高密度化にともなう基板表面の 凹凸のため、ラビング処理の均一性が問題になる。

【0005】そこで、これらの問題を解決する為、ラビ ング処理を用いずに配向処理を行う方法、例えば基板表 面に形成したポリビニルシンナメート、ポリ(4'-メ タクリロイロキシカルコン) などの有機膜に直線偏光さ れた紫外線を照射することにより液晶配向能を付与する ことが検討されている。しかしながら、320 nm以上 の長波長光からなる偏光紫外線に対する感度や液晶配向 能の安定性および耐熱性が十分でないという問題があ る。ここでいう感度とは液晶配向能を付与するに必要な 最小の紫外線照射エネルギー量であり、必要な最小の紫 外線エネルギー量は、一般的には小さいことが望まし

【0006】偏光紫外線に対する感度が十分でないとい う問題は工業的には処理時間や処理コストの面で不利で あり、液晶配向能の安定性および耐熱性の問題は液晶表 示素子として著しく表示品質を低下させることになる。 [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、表示 不良や素子破壊といった製品不良の原因となるラビング 処理を不要とし、感度、液晶配向能の安定性および耐熱 性に優れ、生産性にも優れている液晶配向膜の形成に用 いられる液晶配向剤を提供することにある。

【0008】本発明の他の目的は、前記液晶配向剤から 得られた液晶配向膜に、放射線を照射することを特徴と する液晶配向処理方法を提供することにある。本発明の さらに他の目的および利点は、以下の説明から明らかに なろう。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、本発明 の上記目的および利点は、第1に、(A)下記式(I) $-P^{1}-CH=CH-CO-Q^{1}-$ • • • • • (1) ここで、P'およびQ'は同一もしくは異なり、芳香環を 有する2価の有機基である、で表される構造(以下、特 定構造1という)を主鎖に有するポリイミド(以下、 「ポリイミド(A)」ともいう)、(B)下記式(II) $-P^{2}-CH=CH-CO-O^{2}$ ここで、P²は芳香環を含有する2価の有機基でありそ して Q° は芳香環を含有する1価の有機基である、で表 わされる構造および下記式(III)

3 $-P^3-CH=CH-CO-Q^3$

ここで、P³は芳香環を含有する3価の有機基でありそ して〇 は芳香環を含有する1価の有機基である、で表 わされる構造よりなる群から選ばれる少なくとも1つの 構造(以下、特定構造2という)を有する重合体(以 下、「重合体(B)」ともいう)並びに(C)下記一般 式 (IV)

 $P^4 - CH = CH - CO - O^4$ · · · · · (IA) ここで、P およびQ は同一もしくは異なり、芳香環を 有する1価の有機基である、で表わされる構造(以下、 特定構造3という)を有する化合物(以下、「化合物 (C)」ともいう)よりなる群から選ばれる少なくとも 2種を含有することを特徴とする液晶配向剤によって達 成される。

【0010】また、本発明の上記目的および利点は、第 2に、前記液晶配向剤から得られた液晶配向膜に放射線 を照射することを特徴とする液晶配向処理方法によって 達成される。

【0011】以下、本発明を詳細に説明する。 液晶配向剤

本発明の液晶配向剤は、

- (i) ポリイミド(A) と重合体(B)
- (ii) ポリイミド(A)と化合物(C)
- (iii) 重合体(B)と化合物(C) 並びに
- (iv) ポリイミド(A)と、重合体(B) および化合物 (C) のいずれかを含有する。
- 【0012】 さらに、(i)、(iii) および(iv) に おける好ましい様態としては、
- (i-1) ポリイミド (A) と、ポリイミド以外の構造 30 を有する重合体(B)
- (iii-1)ポリイミド構造を有する重合体(B)と、 ポリイミド以外の構造を有する重合体(B)および化合 物(C)

(iv-1) ポリイミド(A) と、ポリイミド以外の構造 を有する重合体(B)および化合物(C)の組み合わせ を挙げることができる。

【0013】先ず、上記(i)の態様について説明す る。ポリイミド(A)において、該特定構造1は放射線 に感応する構造である。ここでいう"感応"とは、放射 線の照射を受けると、光励起反応によってエネルギー準 位が高まり、次いでエネルギーを放出して安定状態に戻 ることを意味する。前記式(I)において、P'および Q¹は同一もしくは異なり、芳香環を有する2価の有機 基である。芳香環を含有する有機基は、好ましくは、炭 素数6~20の有機基である。これらの有機基には、ハ ロゲン原子が含まれていてもよい。具体的には、1,2 -フェニレン基、1,3-フェニレン基、1,4-フェニ レン基、4,4'ービフェニレン基、4ーペンチルフェ ニル基、4-フルオロフェニル基、3,4-ジフルオロ

フェニル基、3,4,5-トリフルオロフェニル基、4-オクチルフェニル基、4-ペンチルビフェニル基、4-オクチルビフェニル基、4-フルオロビフェニル基、 3,4-ジフルオロビフェニル基、3,4,5-トリフル オロビフェニル基、4-オクチル-1-ナフチル基、5 ーペンチルー1ーナフチル基、6ーオクチルー2ーナフ チル基、9-アントラセニル基、10-ペンチル-9-アントラセニル基などが挙げられる。

【0014】本発明で用いられるポリイミド(A)は、 前記特定構造1を主鎖に有し、(イ)テトラカルボン酸 二無水物と、(ロ)ジアミン化合物とを反応させ、中間 体のポリアミック酸を経て得られる。かかるポリイミド (A) は、(イ) テトラカルボン酸二無水物成分と

(ロ) ジアミン成分の少なくとも一方の成分に、前記特 定構造1を有する化合物が用いて製造される。また、前 記ポリイミド(A)には、ポリアミック酸が完全にイミ ド化されていない、イミド化率の低いものも含まれる。

【0015】特定構造1を有するテトラカルボン酸二無 水物としては、例えば3,3',4,4'ーカルコンテト ラカルボン酸二無水物、4,4',5,5'ーカルコンテ トラカルボン酸二無水物、3,3',5,5'-カルコン テトラカルボン酸二無水物、4,4'-ジヒドロキシカ ルコンビストリメリテートおよび3,4'-ジヒドロキ シカルコンビストリメリテートなどが挙げられる。特定 構造1を有するジアミン化合物としては、例えば3, 3'ージアミノカルコン、4,4'ージアミノカルコ ン、3,4'ージアミノカルコンおよび3',4ージアミ ノカルコンなどが挙げられる。これらは単独でまたは2 種以上を組み合わせて使用できる。

【0016】本発明において用いられるポリイミド

(A) は、本発明の効果を損なわない程度に他のテトラ カルボン酸二無水物および/またはジアミン化合物を併 用して製造することができる。

【0017】他のテトラカルボン酸二無水物としては、 例えば、2,3,5-トリカルボキシシクロペンチル酢酸 二無水物、ブタンテトラカルボン酸二無水物、1,2, 3,4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、1,3 ージメチルー1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボ ン酸二無水物、1,2,3,4-シクロペンタンテトラカ ルボン酸二無水物、3,5,6-トリカルボキシノルボル ナン-2-酢酸二無水物、2,3,4,5-テトラヒドロ フランテトラカルボン酸二無水物、1,3,3a,4,5, 9b-ヘキサヒドロ-5-(テトラヒドロ-2.5-ジ オキソー3ーフラニル)ーナフト[1,2-c]ーフラ ン-1,3-ジオン、5-(2,5-ジオキソテトラヒド ロフラル) -3-メチル-3-シクロヘキセン-1,2 ージカルボン酸二無水物、ビシクロ[2.2.2]ーオク 50 トー7ーエンー2,3,5,6ーテトラカルボン酸二無水

物などの脂肪族および脂環式テトラカルボン酸二無水物;

【0018】ピロメリット酸二無水物、3.3',4. 4'ービフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、 1,4,5,8ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、 2,3,6,7ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、 3,3',4,4'ービフェニルエーテルテトラカルボン 酸二無水物、3,3',4,4'-ジメチルジフェニルシ ランテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'ーテ トラフェニルシランテトラカルボン酸二無水物、1,2, 3.4-フランテトラカルボン酸二無水物、4,4'ービ ス(3,4-ジカルボキシフェノキシ)ジフェニルスル フィド二無水物、4,4'ービス(3,4ージカルボキシ フェノキシ) ジフェニルスルホン二無水物、4,4'-ビス(3,4-ジカルボキシフェノキシ)ジフェニルプ ロパン二無水物、3,3',4,4'-パーフルオロイソ プロピリデンテトラカルボン酸二無水物、3,3',4, 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、ビス(フ タル酸)フェニルホスフィンオキサイド二無水物、p-フェニレンービス(トリフェニルフタル酸)二無水物、 mーフェニレンービス(トリフェニルフタル酸)二無水 物、ビス(トリフェニルフタル酸)-4,4'-ジフェ ニルエーテル二無水物、ビス(トリフェニルフタル酸) -4.4'ージフェニルメタン二無水物などの芳香族テ トラカルボン酸二無水物を挙げることができる。

【0019】これらのうち、2,3,5ートリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物、ブタンテトラカルボン酸二無水物、1,3ージメチルー1,2,3,4ーシクロブタンテトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4ーシクロブタンテトラカルボン酸二無水物、ピロメリット酸二無水物、30物、3,3',4,4'ービフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、1,4,5,8ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、2,3,6,7ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'ービフェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物が好ましい。これらは単独でまたは2種以上を組み合わせて使用できる。

フェノキシ)フェニル]プロパン、2,2-ビス「4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] ヘキサフルオロプ ロパン、2,2-ビス(4-アミノフェニル)へキサフ ルオロプロパン、2,2-ビス[4-(4-アミノフェ ノキシ)フェニル]スルホン、1,4-ビス(4-アミ ノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(4-アミノフ ェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノ キシ) ベンゼン、9,9-ビス(4-アミノフェニル) -10-ヒドロアントラセン、2,7-ジアミノフルオ レン、9,9-ビス(4-アミノフェニル)フルオレ ン、4,4'ーメチレンービス(2ークロロアニリ (2,2), (5,5), (-7), (-ミノビフェニル、2,2'ージクロロー4,4'ージアミ J - 5.5' - ジメトキシビフェニル、<math>3.3' - ジメトキシー4,4'ージアミノビフェニル、1,4.4'ー (p-フェニレンイソプロピリデン) ビスアニリン、 4,4'-(m-フェニレンイソプロピリデン) ビスア ニリン、2,2'ービス[4-(4-アミノー2-トリ フルオロメチルフェノキシ)フェニル] ヘキサフルオロ プロパン、4,4'ージアミノー2,2'ービス(トリフ ルオロメチル)ビフェニル、4,4'ービス[(4ーア ミノー2ートリフルオロメチル)フェノキシ]ーオクタ フルオロビフェニルなどの芳香族ジアミン;ジアミノテ トラフェニルチオフェンなどのヘテロ原子を有する芳香 族ジアミン;

【0021】1,1-メタキシリレンジアミン、1,3-プロパンジアミン、テトラメチレンジアミン、ペンタメチレンジアミン、ヘオクタメチレンジアミン、ノナメチレンジアミン、オクタメチレンジアミン、ノナメチレンジアミン、4,4-ジアミノへプタメチレンジアミノンクロヘキサン、イソホロンジアミン、ヘキサヒドロー4,7-メタノインダニレンジメチレンジアミン、トリシクロ[6.2.1.0^{2,7}]ーウンデシレンジメチルジアミン、4,4'ーメチレンビス(シクロヘキシルアミン)などの脂肪族および脂環式ジアミン;ジアミノヘキサメチルジシロキサンなどのジアミノオルガノシロキサンが挙げられる。

【0022】これらのうち、p-フェニレンジアミン、40 4,4'-ジアミノジフェニルメタン、1,5-ジアミノナフタレン、2,7-ジアミノフルオレン、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、4,4'-(p-フェニレンイソプロピリデン)ビスアニリン、2,2-ビス [4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス(4-アミノフェニル)ヘキサフルオロプロパン、2,2'-ビス [4-(4-アミノ-2-トリフルオロメチルフェノキシ)フェニル] ヘキサフルオロプロパン、4,4'-ジアミノ-2,2'-ビス(トリフルオロメチル)ビフェニル、4,4'-ビス [(4-アミノ-2-トリフルオロメチル)フェノキ

シ] ーオクタフルオロビフェニルが好ましい。これらは 単独でまたは2種以上を組み合わせて使用できる。

【0023】本発明において用いられるポリイミド

(A) は、前記(イ)テトラカルボン酸二無水物成分と (ロ) ジアミン成分を重縮合させてポリアミック酸を得 て、次いで必要に応じて脱水剤およびイミド化触媒の存 在下で加熱して、イミド化することにより得られる。加 熱によりイミド化する場合の反応温度は、通常60~3 00℃、好ましくは100~170℃である。反応温度 が60℃未満では反応の進行が遅れ、また300℃を越 えるとポリアミック酸の分子量が大きく低下することが ある。また、脱水剤及びイミド化触媒の存在下でイミド 化する場合の反応は、有機溶媒中で行うことができる。 反応温度は、通常0~180℃、好ましくは60~15 0℃である。前記脱水剤としては、無水酢酸、無水プロ ピオン酸、無水トリフルオロ酢酸などの酸無水物を用い ることができる。また、イミド化触媒としては、例えば ピリジン、コリジン、ルチジン、トリエチルアミンなど の3級アミンを用いることができる。しかし、これらに 限定されるものではない。脱水剤の使用量は、ポリアミ ック酸の繰り返し単位1モルに対して1.6~20モル とするのが好ましい。また、イミド化触媒の使用量は使 用する脱水剤1モルに対し、0.5~10モルとするの が好ましい。このイミド化触媒、脱水剤の使用量によっ て、ポリイミド中のアミック酸残基の含有率を調整する ことができる。

【0024】本発明の液晶配向剤を構成する特定構造2 を有する前記重合体(B)は、前記特定構造2を有する 重合体であって、重合体の骨格には特に制限はない。

(1) ポリイミド、(2) ポリエステル、(3) ポリア ミドおよび(4)ポリ(メタ)アクリレートから選ばれ るものが好ましい。

【0025】特定構造2は、放射線に感応し、上記式 (II) または上記式(III) で表わされる。式(II) に おいてP²は芳香環を有する2価の有機基でありそして ()² は芳香環を有する 1 価の有機基である。また、式(I II) において、P³は芳香環を有する3価の有機基であ りそして〇 は芳香環を有する1 価の有機基である。こ れらの有機基としては、特定構造1について記述した有 機基と同じ基および同じ骨格を持つ基が挙げられる。

【0026】前記ポリイミドは、ポリイミド(A)と同*

$$C_nH_{2n+1}-A^{-1}C_{-1}-C_{$$

【0028】前記ポリエステルは、(ハ)ジカルボン酸 類(ジカルボン酸、ジカルボン酸エステルまたはジカル ボン酸ハロゲン化物)と、(二)ジオール化合物とを反 応させて得られる。かかるポリエステルは、(ハ)ジカ ルボン酸類と、(二)ジオール化合物の少なくとも一方 の成分に、前記特定構造2を有する化合物を用いて製造 50

* 様に、(イ) テトラカルボン酸二無水物と、(ロ) ジア ミン化合物とを反応させ、中間体のポリアミック酸を経 て得られる。かかるポリイミドは、(イ)テトラカルボ ン酸二無水物成分と(ロ)ジアミン成分の少なくとも一 方の成分に、前記特定構造2を有する化合物を用いて製 造される。また、前記ポリイミド(A)と同様に、重合 体(B)がポリイミドである場合には、ポリアミック酸 が完全にイミド化されていない、イミド化率の低いもの も含まれる。特定構造2を有するテトラカルボン酸二無 水物としては、例えば、2,2'ービス(4-カルコニ ルオキシ) -3,3',4,4'-ビフェニルテトラカル ボン酸二無水物、3,3'ービス(4ーカルコニルオキ シ)-4,4',5,5'-ビフェニルテトラカルボン酸 二無水物、2,2'ービス(4ーカルコニルオキシ)-4,4',5,5'ービフェニルテトラカルボン酸二無水 物、4,4' -ビス (4-カルコニルオキシ) - 2,2',3,3'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物、 6,6' - \forall 2,2' 33'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物、5,5' $- \forall \lambda (4 - \lambda \lambda) = - (4 - \lambda \lambda) = - (4 - \lambda$ ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、2,2'ービス (4-)ニルエーテルテトラカルボン酸二無水物、3,3'ービ ス (4-カルコニルオキシ) -4,4',5,5'-ジフ ェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物、2,2'-ビス(4-カルコニルオキシ)-4,4',5,5'-ジ フェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物、4.4' -ビス(4-カルコニルオキシ)-2,2',3,3'-ジフェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物、6, 6'-ビス(4-カルコニルオキシ)-2,2',3, 3' ージフェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物、 5,5' - \forall 2,2' 3,3'ージフェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物な どが挙げられる。特定構造2を有するジアミン化合物と しては、例えば、2,3-ジアミノカルコン、2,4-ジ アミノカルコン、3,4-ジアミノカルコン、3,5-ジ アミノカルコン、4-(2,4-ジアミノフェノキシ) カルコン、4-(3,5-ジアミノフェノキシ)カルコ ン、下記式(V)で表される化合物などが挙げられる。

【化1】 (V)

される。

[0027]

【0029】特定構造2を有するジカルボン酸類として は、例えば、2,3-カルコンジカルボン酸、2,4-カ ルコンジカルボン酸、3,4-カルコンジカルボン酸、 3,4-カルコンジカルボン酸、3,5-カルコンジカル ボン酸、1-(4-カルコニルオキシ)-2,4-ベン

ゼンジカルボン酸、1-(4-カルコニルオキシ)-2,5-ベンゼンジカルボン酸、1-(4-カルコニル オキシ)-2,6-ベンゼンジカルボン酸および1-(4-カルコニルオキシ)-3,5-ベンゼンジカルボ ン酸それぞれのアルキルエステルなどのエステル化合 物、カルボン酸クロリドなどのカルボン酸ハロゲン化物 が挙げられる。特定構造2を有するジオール化合物とし ては、例えば2,3ージヒドロキシカルコン、2,4ージ ヒドロキシカルコン、3,4-ジヒドロキシカルコン、 3,4-ジヒドロキシカルコン、<math>3,5-ジヒドロキシカ 10 ルコン、1-(4-カルコニルオキシ)-2,4-ベン ゼンジオール、1-(4-カルコニルオキシ)-2,5 ーベンゼンジオール、1-(4-カルコニルオキシ)-2,6-ベンゼンジオールおよび1-(4-カルコニル オキシ) -3,5-ベンゼンジオールなどが挙げられ る。これらのうち、1-(4-カルコニルオキシ)-3,5-ベンゼンジカルボン酸および1-(4-カルコ ニルオキシ) -3,5-ベンゼンジオールが好ましい。 これらは単独でまたは2種以上を組み合わせて使用でき

9

【0030】上記ポリエステルは、本発明の効果を損な わない程度に他のジカルボン酸類および/またはジオー ル化合物を併用して製造することができる。

【0031】他のジカルボン酸類化合物としては、例え ばシュウ酸、マロン酸、ジフルオロマロン酸、アルキル マロン酸、コハク酸、テトラフルオロコハク酸、アルキ ルコハク酸、(土)ーリンゴ酸、meso-酒石酸、イ タコン酸、マレイン酸、メチルマレイン酸、フマル酸、 メチルフマル酸、アセチレンジカルボン酸、グルタル 酸、ヘキサフルオログルタル酸、メチルグルタル酸、グ ルタコン酸、アジピン酸、ジチオアジピン酸、メチルア ジピン酸、ジメチルアジピン酸、テトラメチルアジピン 酸、メチレンアジピン酸、ムコン酸、ガラクタル酸、ピ メリン酸、スベリン酸、パーフルオロスベリン酸、3, 3,6,6ーテトラメチルスベリン酸、アゼライン酸、セ バシン酸、パーフルオロセバシン酸、ブラシル酸、ドデ シルジカルボン酸、トリデシルジカルボン酸、テトラデ シルジカルボン酸などの脂肪族カルボン酸;

【0032】シクロアルキルジカルボン酸、アジピン 酸、ヘキサヒドロフタル酸、1,4-(ノルボルネン) ジカルボン酸、ビシクロアルキルジカルボン酸、アダマ ンタンジカルボン酸、スピロヘプタンジカルボン酸など の脂環式カルボン酸;

【0033】フタル酸、イソフタル酸、ジチオイソフタ ル酸、メチルイソフタル酸、ジメチルイソフタル酸、ク ロロイソフタル酸、ジクロロイソフタル酸、テレフタル 酸、メチルテレフタル酸、ジメチルテレフタル酸、クロ ロテレフタル酸、ブロモテレフタル酸、ナフタレンジカ ルボン酸、オキソフルオレンジカルボン酸、アントラセ ンジカルボン酸、ビフェニルジカルボン酸、ビフェニレ 50

ンジカルボン酸、ジメチルビフェニレンジカルボン酸、 4,4''-p-テレフェニレンジカルボン酸、4、 4['], 'ーpークワレルフェニルジカルボン酸、ビベン ジルジカルボン酸、アゾベンゼンジカルボン酸、ホモフ タル酸、フェニレン二酢酸、フェニレンジプロピオン 酸、ナフタレンジカルボン酸、ナフタレンジプロピオン 酸、ビフェニル二酢酸、ビフェニルジプロピオン酸、 ン) ジプロピオン酸、4,4'-ビベンジル二酢酸、3, 3'-(4,4'-ビベンジル)ジプロピオン酸、オキ シジーpーフェニレン二酢酸などの芳香族ジカルボン酸 およびそれぞれのアルキルエステルなどのエステル化合 物、カルボン酸クロリドなどのカルボン酸ハロゲン化物 が挙げられる。これらは単独でまたは2種以上を組み合 わせて使用できる。

【0034】他のジオール化合物としては、例えばカテ コール、アルキルカテコール、ヒドロキノンなどの多価 フェノール類;メチレンビスフェノール、イソプロピリ デンビスフェノール、ブチリデンビスフェノール、チオ ビスフェノール、スルフィニルビスフェノール、スルフ オニルンビスフェノール、オキシビスフェノールなどの ビスフェノール類が挙げられる。これらは単独でまたは 2種以上を組み合わせて使用できる。

【0035】かかるポリエステルは、前記(ハ)ジカル ボン酸類成分と(二)ジオール化合物成分とを、必要に 応じて触媒存在下で加熱し重縮合させて得られる。ジカ ルボン酸とジオール化合物との重縮合の場合は、触媒と して、硫酸、pートルエンスルフォン酸等のプロトン 酸、重金属の酸化物または塩、チタン、スズ、鉛などの 有機金属化合物等が用いられる。ジカルボン酸エステル とジオール化合物との反応の場合は、触媒として、鉛、 亜鉛、マンガン、カルシウム、コバルト、カドミウムな どの酢酸塩や炭酸塩化合物、金属マグネシウム、亜鉛、 鉛、アンチモン、ゲルマニウムなどの酸化物が用いられ る。ジカルボン酸ハロゲン化物とジオール化合物との反 応の場合は、触媒として、ピリジン、トリエチルアミン などの塩基性触媒が用いられる。

【0036】前記ポリアミドは、(ホ)ジカルボン酸類 (ジカルボン酸、ジカルボン酸エステル、ジカルボン酸 ハロゲン化物)と、(へ)ジアミン化合物とを反応させ て得られる。かかるポリアミドは、(ホ)ジカルボン酸 類成分と(へ)ジアミン化合物成分の少なくとも一方の 成分に、特定構造2を有する化合物を用いて製造され る。

【0037】特定構造2を有するジカルボン酸類として は、先に挙げたジカルボン酸類(ハ)が用いられる。ま た、特定構造2を有するジアミン化合物としては、先に 挙げたジアミン化合物(ロ)に加えて下記式(V)で表 される化合物などが挙げられる。

[0038]

[化2]

$$C_nH_{2n+1}A^1-C=C-C-A^2-O$$
 NH_2
 NH_2
 NH_2

20

30

(式中、A¹およびA²は2価の芳香族基を表しそしてn は1~10の整数を表す。)

【0039】これらのうち、上記式(V)で表される化 合物が好ましい。上記式(V)中、C。Hand ーで表さ れるアルキル基は、直鎖状であっても分岐鎖状であって もよく、直鎖状のものがより好ましい。 A¹およびA²で 表される2価の芳香族基としては、例えばフェニレン 基、ビフェニレン基、ナフチレン基、ビナフチレン基、 アントリレン基、フェナントリレン基;ピレン、クリセ ン、ナフタセンなどの多環芳香族化合物から水素原子2 個を除いた有機基などが挙げられる。上記式(V)で表 される化合物の具体例としては、4-イソプロピルー 4'(3,5-ジアミノフェノキシ)カルコン、4-ア 4ーペンチルー4'(3,5ージアミノフェノキシ)カ ルコン、4ーオクチルー4'(3,5ージアミノフェノ キシ)カルコン、4ーペンチル-2-メチル-4' (2,4-ジアミノフェノキシ) カルコン、4-ペンチ $\nu - 2,5 ジメチル - 4'(3,5 - ジアミノフェノキ$ シ)カルコン、4ーオクチル-2-メチル-4'(3, 5-ジアミノフェノキシ) カルコン、4-ペンチルー 4'(2,4-ジアミノフェノキシ)カルコン、4-オ クチルー4'(2,4-ジアミノフェノキシ)カルコ ン、4ーペンチルー4'(3,5ージアミノベンゾイロ キシ)カルコン、4-オクチル-4'(3,5-ジアミ ノベンゾイロキシ)カルコン、4ーペンチルー3' (2,4-ジアミノベンゾイロキシ)カルコン、4-オ クチルー3'(2,4-ジアミノベンゾイロキシ)カル コンなどが挙げられ、中でも4-ペンチル-4'(3, 5-ジアミノフェノキシ)カルコン、4-オクチルー 4'(3,5-ジアミノフェノキシ)カルコンが特に好 ましい。これらは単独でまたは2種以上を組み合わせて 使用できる。

【0040】かかるポリアミドには、本発明の効果を損 なわない程度に他のジカルボン酸類化合物、ジアミン化 合物を併用することができる。他のジカルボン酸類化合 40 物、ジアミン化合物としては、先に挙げた他のジカルボ ン酸類化合物及びジアミン化合物が用いられる。これら は単独でまたは2種以上を組み合わせて使用できる。

【0041】かかるポリアミドは、前記(ホ)ジカルボ ン酸類成分と(へ)ジアミン成分とを、必要に応じて、 パラトルエンスルホン酸、硫酸、塩酸、などの酸性触媒 存在下で重縮合させて得られる。

【0042】前記ポリ(メタ)アクリレートは、(ト) (メタ) アクリレート化合物を重合させて得られる。か

リレート化合物に、特定構造2を有する化合物が用いら れる。

【0043】特定構造2を有する(メタ)アクリレート 化合物としては、4-(メタ)アクリロイロキシカルコ ン、4-(メタ)アクリロイロキシ-4'-フェニルカ ルコン、4-(メタ) アクリロイロキシー4' ーペンチ ルカルコン、4-(メタ)アクリロイロキシ-4'-(4-ペンチルフェニル) カルコンなどが挙げられる。 これらは単独でまたは2種以上を組み合わせて使用でき る。

【0044】本発明において用いられるポリ(メタ)ア クリレートは、本発明の効果を損なわない程度に他の (メタ) アクリレート化合物を併用して製造することが できる。他の(メタ)アクリレート化合物としては、メ チル (メタ) アクリレート、エチル (メタ) アクリレー ト、nーブチル(メタ)アクリレート、iーブチル(メ タ) アクリレート、2-ヒドロキシエチル (メタ) アク リレート、2ーヒドロキシプロピル(メタ)アクリレー ト、2-エチルヘキシル(メタ)アクリレート、ポリエ チレングリコールモノ (メタ) アクリレート、トリメチ ロールプロパントリ(メタ)アクリレートなどの脂肪族 (メタ) アクリレート化合物; テトラヒドロフルフリル (メタ) アクリレート、シクロヘキシル (メタ) アクリ レート、グリシジル(メタ)アクリレート、ジシクロペ ンタジエン(メタ)アクリレート、ジシクロペンタニル (メタ) アクリレート、トリシクロデカニル(メタ) ア クリレート、イソボルニル (メタ) アクリレートなどの 脂環式(メタ)アクリレート化合物;ベンジル(メタ) アクリレート、2-ヒドロキシ-3-フェニルオキシプ ロピル(メタ)アクリレート、トリス(2-ヒドロキシ エチル) イソシアヌレートトリ (メタ) アクリレートな どの芳香族(メタ)アクリレート化合物などが挙げられ る。これらは単独でまたは2種以上を組み合わせて使用 できる。

【0045】かかるポリ(メタ)アクリレートは、前記 (ト) (メタ) アクリレート化合物を、必要に応じて、 アゾビスイソブチロニトリルなどのアゾ化合物、過酸化 ベンゾイルなどの過酸化物などの触媒存在下で重合して 得られる。

【0046】次に、前記態様(ii)について説明する。 ポリイミド(A)としては先に挙げたものと同じポリイ ミドを用いることができる。化合物(C)は前記一般式 (IV)で示される放射線に感応する構造を有する化合物で ある。式(IV)中、P⁴およびQ⁴は、芳香環を含有する有 機基であり、好ましくは、炭素数6~20の有機基であ かるポリ(メタ)アクリレートは、(ト)(メタ)アク 50 る。これらの有機基には、ハロゲン原子が含まれていて

もよい。具体的には、フェニル基、4,4'ービフェニレン基、4ーペンチルフェニル基、4ーフルオロフェニル基、3,4,5ートリフルオロフェニル基、4ーオクチルフェニル基、4ーペンチルビフェニル基、4ーオクチルビフェニル基、4ーオクチルビフェニル基、3,4,5ートリフルオロビフェニル基、3,4,5ートリフルオロビフェニル基、4ーオクチルー1ーナフチル基、5ーペンチルー1ーナフチル基、6ーオクチルー2ーナフチル基、9ーアントラセニル基、10ーペンチルー9ーアントラセニル基などが挙げられる。これらは互いに同一でも異なっていてもよい。【0047】最後に、前記態様(iii)および(iv)については、前記態様(i)と(ii)の説明から理解されよう。本発明における、ポリイミド(A)、重合体

(B) および化合物 (C) の混合割合は、ポリイミド

(A) を用いる場合には、ポリイミド(A) 対重合体

(B) および/または化合物 (C) の混合重量比が、好ましくは $1:0.8\sim0.001$ であり、より好ましくは $1:0.3\sim0.01$ である。またポリイミド (A) を用いない場合には、重合体 (B) 対化合物 (C) の混合重 20量比が、好ましくは $1:0.8\sim0.001$ であり、より好ましくは $1:0.3\sim0.01$ である。

【0048】溶剤

本発明の液晶配向剤は、前記の放射線に感応する有機化合物を含有する組成物の溶液から成る。この際用いられる溶剤としては、該組成物を溶解し得る有機溶剤であれば特に制限はなく、単独または2種以上の溶剤を組み合わせて使用できる。

【0049】その他の添加剤

本発明の液晶配向剤は、プレチルト角の安定化および塗膜強度アップのために、種々の熱硬化性の架橋剤を含有することもできる。熱硬化性架橋剤としては、多官能エポキシ含有化合物が有効であり、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、環状脂肪族エポキシ樹脂、グリシジルジアミン系エポキシ樹脂、複素環式エポキシ樹脂、エポキシ基含有アクリル樹脂などが使用できる。市販品では、例えばエポライト400E、同3002(共栄社油脂化学工業(株)製)、エピコート828、同152、エポキシノボラック180S(油化シェルエポキシ

(株) 製)などを挙げることができる。さらに、前述の 多官能エポキシ含有化合物を使用する際、架橋反応を効 率良く起こす目的で、1ーベンジルー2ーメチルイミダ ゾールなどの塩基触媒を添加することができる。

【0050】また、本発明の液晶配向剤は、基板との接着性を改善する目的で、官能性シラン含有化合物を含有することができる。官能性シラン含有化合物としては、例えば、3-アミノプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルトリエトキシシラン、2-アミノプロピ 50

ルトリメトキシシラン、2-アミノプロピルトリエトキ シシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロ ピルトリメトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、3-ウレ イドプロピルトリメトキシシラン、3-ウレイドプロピ ルトリエトキシシラン、N-エトキシカルボニルー3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-エトキシカル ボニルー3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-トリエトキシシリルプロピルトリエチレントリアミン、 N-トリメトキシシリルプロピルトリエチレントリアミ ン、10-トリメトキシイシリル-1,4,7-トリアザ デカン、10-トリエトキシシリル-1,4,7-トリア ザデカン、9-トリメトキシシリル-3,6-ジアザノ ニルアセテート、9ートリエトキシシリルー3,6ージ アザノニルアセテート、N-ベンジル-3-アミノプロ ピルトリメトキシシラン、N-ベンジルー3-アミノプ ロピルトリエトキシシラン、N-フェニルー3-アミノ プロピルトリメトキシシラン、N-フェニルー3-アミ ノプロピルトリエトキシシラン、N-ビス(オキシエチ レン) -3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-ビス (オキシエチレン) -3-アミノプロピルトリエト キシシランなどを挙げることができる。さらに特開昭6 3-291922号公報記載のテトラカルボン酸二無水 物とアミノ基含有シラン化合物との反応物などを挙げる こともできる。

【0051】液晶配向膜

本発明の液晶配向剤を用いて液晶配向膜を形成する方法 としては、例えば次の方法が挙げられる。まず、透明導 電膜が設けられた基板の透明導電膜側に、本発明の液晶 配向剤をロールコーター法、スピンナー法、印刷法等に より塗布し、40~200℃の温度で加熱して塗膜を形 成させる。塗膜の膜厚は、通常0.001~1µm、好 ましくは $0.005\sim0.5\mu$ mである。前記基板として は、例えばフロートガラス、ソーダガラス等のガラス、 ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレ ート、ポリエーテルスルホン、ポリカーボネート等のプ ラスチックフィルム等からなる透明基板を用いることが できる。前記透明導電膜としては、SnO2からなるN ESA膜、In2O3-SnO2からなるITO膜等を用 いることができ、これらの透明導電膜のパターニングに は、フォト・エッチング法、予めマスクを用いる方法等 が用いられる。液晶配向剤の塗布に際しては、基板およ び透明導電膜と塗膜との接着性をさらに良好にするため に、基板および透明導電膜上に、予め官能性シラン含有 化合物、チタネート等を塗布することもできる。

【0052】次いで、前記塗膜に放射線を照射し、場合によってはさらに150~250 ℃の温度で加熱処理を行い、プレチルト角を有する液晶配向能を付与する。使用される放射線は、偏光されていても偏光されていなくてもよく、150nm~800nmの波長を有する紫外

線および可視光線を用いることができるが、320nm ~450nm の波長を有する紫外線が特に好ましい。前記光源としては、例えば低圧水銀ランプ、高圧水銀ランプ、重水素ランプ、メタルハライドランプ、アルゴン共鳴ランプ、キセノンランプ、エキシマーレーザー等が使用できる。

15

【0053】前記の好ましい波長領域の紫外線は、フィ ルター、回析格子などを前記光源と併用することにより 得ることができるが、簡便には、偏光板としてパイレッ クスガラス製偏光板など320nmより短い波長の紫外 線を透過しないものを、前記光源とともに用いてもよ い。偏光成分を有する紫外線を液晶配向膜に照射するに は、前記光源から照射された光線を、液晶配向膜と光源 の間に配置した偏光板や偏光子を通過させることで達成 できる。偏光した光に代えて、偏光していない紫外線を 斜めより照射しても、偏光した光を照射した場合と同様 な効果を得ることができる。物体に斜めより照射された 偏光していない紫外線は、比較的高い反射率を示す。こ の反射率は偏光成分により異なる。一般に、光の入射面 内の偏光成分である p 成分に較べ、入射面に対して垂直 20 な偏光成分であるs成分の反射率が高いという性質を持 つ。このことは、反射率の低い偏光成分であるp成分が 選択的に物体中に入射されることを意味する。

【0054】また、液晶配向膜へ照射する偏光成分を有する紫外線の偏光軸の方向、偏光成分を有する紫外線の角度および照射強度を変えて、液晶配向膜に複数回の偏光成分を有する紫外線を照射することで、液晶分子の配向方向とプレチルト角を制御することが可能である。

【0055】液晶表示素子

本発明の液晶配向剤を用いて形成される液晶表示素子 は、前記液晶配向膜が形成された2枚の基板を、紫外線 の照射により付与された配向方向の方位角方向が所定の 角度となるように、間隙(セルギャップ)を介して対向 させ、基板の間の周辺部をシール剤でシールし、液晶を 充填し、充填孔を封止して液晶セルを構成する。そし て、その両面に偏光板の偏光方向がそれぞれ基板の配向 方向の方位角方向と所定の角度を成すように偏光板を張 り合わせることにより、液晶表示素子とする。液晶配向 膜が形成された2枚の基板における、配向方向の方位角 方向およびそれぞれの基板と偏光板との角度を調整する ことにより、TN型またはSTN型液晶セルを有する液 晶表示素子を任意に得ることができる。前記シール剤と しては、例えば硬化剤およびスペーサーとしての酸化ア ルミニウム球を含有したエポキシ樹脂等を用いることが できる。

【0056】前記液晶としては、ネマティック型液晶、スメクティック型液晶などを用いることができる。TN型液晶セルの場合、ネマティック型液晶を形成させるものが好ましく、例えばシッフベース系液晶、アゾキシ系液晶、ビフェニル系液晶、フェニルシクロヘキサン系液50

晶、エステル系液晶、ターフェニル系液晶、ビフェニルシクロヘキサン系液晶、ピリミジン系液晶、ジオキサン系液晶、ビシクロオクタン系液晶、キュバン系液晶等が用いられる。またSTN型液晶セルの場合、前記液晶に、例えばコレステリルクロライド、コレステリルノナート、コレステリルカーボネート等のコレステリック液晶や商品名C-15,CB-15(メルク社製)として販売されているようなカイラル剤等をさらに添加して使用することもできる。さらに、pーデシロキシベンジリデンーpーアミノー2ーメチルブチルシンナメート等の強誘電性液晶も使用することができる。液晶セルの外側に使用される偏光板としては、ポリビニルアルコールを延伸配向させながら、ヨウ素を吸収させたH膜と呼ばれる偏光膜を酢酸セルロース保護膜で挟んだ偏光板、又はH膜そのものからなる偏光板等を挙げることができる。

【0057】本発明の液晶配向剤および液晶配向処理方法を用い、前記方法により液晶配向膜を形成すれば、表示不良や素子破壊といった製品不良の原因となるラビング処理を不要とし、感度、液晶配向能の安定性および耐熱性に優れた液晶配向膜を高い歩留まりで形成できる。

[0058]

【実施例】以下、本発明を実施例により、さらに具体的 に説明するが、本発明はこれらの実施例に制限されるも のではない。

【0059】合成例1 (ポリイミド(A)の合成) ポリアミック酸の重合

2,3,5-トリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物 0.1 モル(22.4 g)と3', 4-ジアミノカルコン 0.1 モル(23.8 g)をN-メチル-2-ピロリドン 400 g に溶解させ、60 $\mathbb C$ で6時間反応させた。次いで、反応混合物を大過剰のメタノールに注ぎ、反応生成物を沈澱させた。その後、メタノールで洗浄し、減圧下 40 $\mathbb C$ $\mathbb C$

イミド化反応

30

得られたポリアミック酸 $15.0 \, \mathrm{g} \ln \mathrm{N}$ - N $\mathrm{N$

【0060】合成例2(重合体(B)の合成)ポリアミック酸の重合

間反応させた。次いで、反応混合物を大過剰のメタノールに注ぎ、反応生成物を沈殿させた。その後、メタノールで洗浄し、減圧下 40° で 15 時間乾燥させて、重合体(B)(以下、「重合体(B-1)」という) 43 g を得た。

【0061】合成例3(重合体(B)の合成) ポリメタクリレートの合成

4-メタクリロイロキシカルコン2.5gおよびアゾビスイソブチロニトリル20mgをジグライム7.5mlに溶解し、窒素雰囲気下60℃で10時間反応した。粘 10 凋な反応混合物をメタノールに投入しポリマーを沈殿、乾燥させて、重合体(B)(以下、「重合体(B-2)」という)2.5gを得た。

【0062】合成例4(化合物(C)の合成) 4-ヒドロキシカルコン10.0gと酢酸ナトリウム1 0gを100mlの無水酢酸中、室温で3時間撹拌した。反応溶液を水に注ぎ、沈殿物をろ別、水洗、真空乾燥し化合物(C)(以下、「化合物(C-1)」という)9.6gを得た。

【0063】比較合成例1

ポリアミック酸の重合

2,3,5ートリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物 22.42gとpーフェニレンジアミン10.81gをNーメチルー2ーピロリドン300gに溶解させ、60℃で6時間反応させた。次いで、反応混合物を大過剰のメタノールに注ぎ、反応生成物を沈澱させた。その後、メタノールで洗浄し、減圧下40℃で15時間乾燥させて、ポリアミック酸(27.44g)を得た。

イミド化反応

得られたポリアミック酸 20.00 gにN-メチル-2 ーピロリドン 380 g、ピリジン 9.52 g及び無水酢酸 12.29 gを添加し、120 $\mathbb C$ で 4 時間イミド化反応をさせた。次いで、反応混合液を大過剰のメタノールに注ぎ、反応生成物を沈澱させた。その後メタノールで洗浄し減圧下で 15 時間乾燥させて、比較用ポリイミド(以下、「重合体(a-1)」という) 15.27 gを得た。

【0064】参考例1

 18

脂接着剤をスクリーン印刷塗布した後、一対の基板を液晶配向膜面が相対するように、しかもラビング方向が逆平行となるように重ね合わせて圧着し、接着剤を硬化させた。次いで、液晶注入口より一対の基板間に、ネマティック型液晶(メルク社製、ZLI-1565)を充填した後、エポキシ系接着剤で液晶注入口を封止し、基板の外側の両面に偏光板を、偏光板の偏光方向がそれぞれの基板の液晶配向膜のラビング方向と一致するように張り合わせ、液晶表示素子を作製した。

【0065】実施例1

合成例 1 で得られた重合体(A-1)と合成例 3 で得られた重合体(B-2)を、重量混合比が(B-2)/ (A-1) = 0.1となるように混合した後、比較例 1 と同様に基板上に薄膜を形成した。次いで基板面に形成した薄膜表面に紫外線を照射した。実施例 1 の紫外線照射ではHg-Xe ランプを光源として、可視紫外偏光フィルター SPF-50C-32(シグマ光機製)により、365 n mの波長を主とする320 n m よりも短波長成分を含まない直線偏光を、基板法線方向から0.2 J/c m^2 照射した。液晶配向膜を重ね合わせる向きをラビング方向の代わりに紫外線照射により付与された配向方向の方位角方向に従った以外は、比較例 1 と同様の方法で液晶表示素子を作製した。

【0066】実施例2

実施例1で用いた重合体 (B-2) の代わりに合成例2 で得られた重合体 (B-1) を用いた以外は実施例1と同様に液晶表示素子を作製した。

【0067】実施例3

実施例 1 で用いた重合体 (B-2) の代わりに合成例 4 で得られた化合物 (C-1) を用いた以外は実施例 1 と同様に液晶表示素子を作製した。

【0068】実施例4

照射した紫外線エネルギーが 0.5 J/cm^2 である以外は実施例1と同様な方法で液晶表示素子を作製した。次に作製した液晶表示素子を1500のクリーンオーブン中で30分の加熱を行った後、室温に冷却した。

【0069】実施例5

【0070】実施例6

実施例 5 における第 1 照射と第 2 照射の順番を入れ替えた以外は実施例 5 と同様な方法で液晶表示素子の作製、加熱および冷却を行った。

19

【0071】実施例7

実施例1と同様な方法で基板上に薄膜を形成した後、2回の紫外線照射を行った。照射光および基板の位置関係については、図1に示すようなxyz座標を用いて説明する。図1に示すように紫外線の入射位置を原点にとり、基板面をxy平面、基板法線方向をz軸とする。図中には、一入射光束のみを図示しているが、紫外線は、基板上の膜全体に照射される。各基板上の位置において、第1照射光と第2照射光の位置関係は、以下に説明する位置関係を示すものとする。

【0072】図1に示すように、第1照射光aは、y軸 方向に偏光方向 a α を有する直線偏光光である。この第1 照射光a を基板1 上の薄膜2 に対して法線方向、即ち2 軸方向から0.5 J/c m 2 照射した。

【0073】次に、図2に示すように、第2照射光bを 薄膜2面に対して入射角 $\theta=6$ 0度で0.1 J C m^2 照射した。尚、入射角とは光軸と基板法線とのなす角をい 20 う。第2照射光bは、第1照射光の偏光方向と直交する x z面内に偏光方向 b β を有する。第2 照射光の入射面 b 、第1 照射光の偏光方向と直交する x z 面にある。

【0074】液晶配向膜を重ね合わせる向きをラビング 方向の代わりに紫外線照射により付与された配向方向の 方位角方向に従った以外は、比較例1と同様の方法で液 晶表示素子を作製した。

【0075】参考例1および実施例1~7で得られた液晶表示素子における液晶配向性は良好であった。電圧5*

* Vを印可したところ、印可した電圧のON-OFFに応答して、液晶表示素子の明暗の変化が観察された。

【0076】参考例1および実施例7で得られた液晶表示素子中の液晶分子には、図3に示すような、セル全面にわたって均一なプレチルト角を有する配向を液晶分子に付与することができた。

[0077]

【発明の効果】本発明の液晶配向剤を用いた液晶配向膜の形成方法によれば、従来のラビング処理の際に発生する静電気によるほこりの付着、TFT素子の回路破壊が発生しないうえ、液晶配向の安定性および耐熱性にすぐれた液晶配向膜を高い歩留まりで形成できる。また、本発明の液晶配向剤を用いて形成された液晶配向膜はプレチルト角を有する配向制御が容易であり面内均一性に優れているため、TN型、STN型等の表示用として用いた場合に高い表示品位を持つ液晶表示素子が得られ、種々の装置に有効に使用でき、例えば卓上計算機、腕時計、置時計、係数表示板、ワードプロセッサ、パーソナルコンピューター、液晶テレビ等の表示装置に好適に用20 いられる。

【図面の簡単な説明】

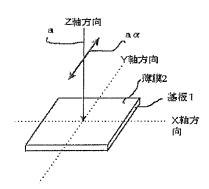
【図1】実施例における光照射条件を示す概略斜視図である。

【図2】実施例における光照射条件を示す概略斜視図である。

【図3】液晶表示素子中で液晶分子が均一にプレチルト 角を有して配向していることを示す液晶表示素子の断面 図である。

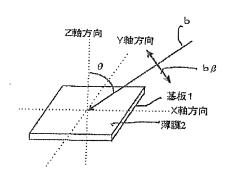
[図1]

図 1



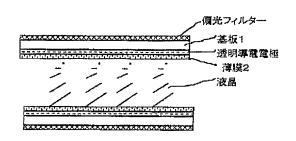
[図2]

|×| 2



【図3】

।×। ३



フロントページの続き

(72)発明者 槙田 穣

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72)発明者 木村 雅之

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72)発明者 別所 信夫

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72)発明者 木村 慎一

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72)発明者 竹内 安正

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

F ターム(参考) 2H090 HB08Y HB09Y HB10Y HC05

KA04 KA14 MB01 MB14

4J002 BG042 BG052 CF002 CF032

CLOO2 CLO32 CMO11 CMO12

EH076 GQ00